

СВЕДЕНИЯ

о ведущей организации по диссертации Казаковой Алёны Евгеньевны на тему:
«Исследование твердых растворов AlInGaPAs, выращенных на подложках
арсенида галлия и фосфида индия в поле температурного градиента»

Полное наименование организации	Сокращенное наименование организации	Место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»	Перечень основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе Российской академии наук	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН	Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 Тел: (812) 297-2245 Адрес электронной почты: post@mail.ioffe.ru Сайт: www.ioffe.ru	1. Khvostikov V.P., Sorokina S.V., Potapovich N.S., Khvostikova O.A., Timoshina N.Kh., Shvarts M.Z. Modification of photovoltaic laser-power ($\lambda = 808$ nm) converters grown by LPE // Semiconductors. 2018. Vol. 52, No. 3. P. 366–370. 2. Nadtochiy A.M., Mintairov S.A., Kalyuzhnyy N.A., Rouvimov S.S., Nevedomskii V.N., Maximov M.V., Zhukov A.E. Bimodality in arrays of In_{0.4}Ga_{0.6}As hybrid quantum-confined heterostructures grown on GaAs substrates // Semiconductors. 2018. Vol. 52, No. 1. P. 53-58. 3. Khvostikov, V.P., Sorokina, S.V., Potapovich, N.S., Khvostikova, O.A., Timoshina, N.K. Laser ($\lambda = 809$ nm) power converter based on GaAs // Semiconductors. 2017. Vol. 51, No. 5. P. 645–648. 4. Musalinov S.B., Anzulevich A.P., Bychkov I.V., Gudovskikh A.S., Shvarts M.Z. Influence of double- and triple-layer antireflection coatings on the formation of photocurrents in multijunction III–V solar cells // Semiconductors. 2017. Vol. 51, No. 1, P. 88-92. 5. Rybalchenko D.V., Mintairov S.A., Salii R.A., Shvarts M.Z., Timoshina N.K., Kalyuzhnyy N.A. Optimization of structural

			and growth parameters of metamorphic InGaAs photovoltaic converters grown by MOCVD // Semiconductors. 2017. Vol. 51, No. 1. P. 93-99. 6. Emelyanov, V.M., Sorokina, S.V., Khvostikov, V.P., Shvarts, M.Z. Simulation of the characteristics of InGaAs/InP-based photovoltaic laser-power converters // Semiconductors. 2016. Vol. 50, No. 1. P. 132–137. 7. Emelyanov, V.M., Mintairov, S.A., Sorokina, S.V., Khvostikov, V.P., Shvarts, M.Z. Simulation of the ohmic loss in photovoltaic laser-power converters for wavelengths of 809 and 1064 nm // Semiconductors. 2016. Vol. 50, No. 1. P. 125–131. 8. Emelyanov V.M., Sorokina S.V., Khvostikov V.P., Shvarts M.Z. Simulation of the characteristics of InGaAs/InP-based photovoltaic laser-power converters // Semiconductors. 2016. Vol. 50, No. 1. P. 132-137. 9. Mintairov S.A., Emelyanov V.M., Rybalchenko D.V., Salii R.A., Timoshina N.K., Shvarts M.Z., Kalyuzhnyy N.A. Heterostructures of metamorphic GaInAs photovoltaic converters fabricated by MOCVD on GaAs substrates // Semiconductors. 2016. Vol. 50, No. 4. P. 517-522. 10. Khvostikov V.P., Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Sorokina S.V., Potapovich N.S., Emelyanov V.M., Timoshina N.K., Andreev V.M. Photovoltaic laser-power converter based on AlGaAs/GaAs heterostructures // Semiconductors. 2016. Vol. 50, No. 9. P. 1220-1224. 11. Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Salii R.A., Nadtochiy A.M., Payusov A.S., Brunkov P.N., Nevedomsky V.N., Shvarts M.Z., Andreev V.M., Luque A., Martí A. Increasing the quantum efficiency of InAs/GaAs QD arrays for solar cells grown by MOVPE without using strain-balance technology // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. 2016. Vol. 24, No. 9. P. 1261-1271.
--	--	--	--

			12. Khvostikov V.P., Sorokina S.V., Khvostikova O.A., Levin R.V., Pushnyi B.V., Timoshina N.Kh., Andreev V.M. GaSb laser-power ($\lambda = 1550$ nm) converters: Fabrication method and characteristics // Semiconductors. 2016. Vol. 50, No. 10. P. 1338–1343. 13. Andreev V.M., Malevskiy D.A., Pokrovskiy P.V., Rumyantsev V.D., Chekalin A.V. On the main photoelectric characteristics of three-junction InGaP/InGaAs/Ge solar cells in a broad temperature range ($-197^{\circ}\text{C} \leq T \leq +85^{\circ}\text{C}$) // Semiconductors. 2016. Vol. 50, No. 10. P. 1374-1379. 14. Levin R.V., Marichev A.E., Shvarts M.Z., Marukhina E.P., Khvostikov V.P., Pushnyi B.V., Mizerov M.N., Andreev V.M. Photovoltaic converters of concentrated sunlight, based on InGaAsP(1.0 eV)/InP heterostructures // Semiconductors. 2015. Vol. 49, No. 5. P. 700–703. 15. Khvostikov, V., Sorokina, S., Potapovich, N., Khvostikova O., Shvarts M., Timoshina N., Andreev V. AlGaAs converters and arrays for laser power beaming // AIP Conference Proceedings. 2015. Vol. 1679. 130002.
--	--	--	---

Председатель диссертационного совета Д 212.101.07

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.101.07



В.А. Бабешко

М.В. Зарецкая